

FT5713M

■特 長

- ・4素子/1パッケージ

■用 途

- ・中速度スイッチング
- ・低周波増幅
- ・リレードライバ
- ・ソレノイドドライバ

■最大定格 〈Ta=25°C〉

項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	50	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	5	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	30	V
コレクタ電流	I_C	500	mA
コレクタ損失	P_C^*	400	mW
接合部温度	T_j	+150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~+150	°C

*1素子動作

■電気的特性 〈Ta=25°C〉

項 目	記 号	条 件	規 格			単 位
			最小値	標準値	最大値	
コレクタしゅ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=12V, I_E=0$	—	—	500	nA
エミッタしゅ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=2.5V, I_C=0$	—	—	500	nA
コレクタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)CB0}$	$I_C=100\mu A, I_E=0$	50	—	—	V
エミッタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E=100\mu A, I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C=10mA, R_{BE}=\infty$	30	—	—	V
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE}	$V_{CE}=2V, I_C=100mA$	30	—	—	—
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=200mA, I_E=10mA$	—	0.3	0.6	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$		—	0.9	1.2	V
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=6V, I_E=0, f=1MHz$	—	—	15	pF
スイッチング時間	上昇時間	$I_C=120mA, I_{B1}=10mA,$	—	—	80	ns
	蓄積時間	$I_{B2}=-5mA$	—	—	800	ns
	下降時間	スイッチング時間測定回路参照	—	—	150	ns

■外形寸法図

